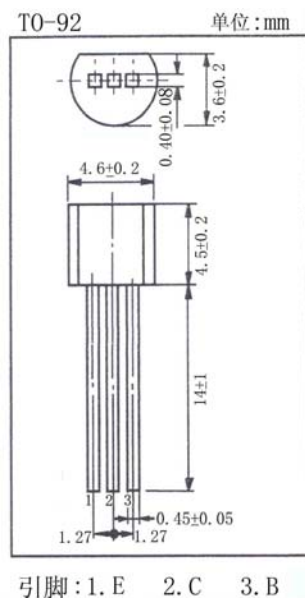


用途:低噪声低频电路,低输入阻抗的前置电路/Purpose:Ultra-low noise low-frequency amplification, low base resistance for use in MC Head amplifiers.

特点:低噪声,基区电阻小,低噪声电压,与 2SD786 (3DG786) 互补/Features:Ultra-low noise, low base resistance, low noise voltage, complementary pair with 2SD786 (3DG786).

极限参数/Absolute maximum ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CB0}	-50	V
V_{CE0}	-40	V
V_{EB0}	-5.0	V
I_C	-300	mA
P_C	250	mW
T_j	150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$



电性能参数/Electrical Characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition	数值 Rating			单位 Unit
		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CB0}	$I_C=-50\ \mu\text{A}$ $I_E=0$	-50			V
V_{CE0}	$I_C=-1.0\text{mA}$ $I_B=0$	-40			V
V_{EB0}	$I_E=-50\ \mu\text{A}$ $I_C=0$	-5.0			V
I_{CB0}	$V_{CB}=-30\text{V}$ $I_E=0$			-0.5	μA
I_{EB0}	$V_{EB}=-4.0\text{V}$ $I_C=0$			-0.5	μA
h_{FE}	$V_{CE}=-6.0\text{V}$ $I_C=-10\text{mA}$	120		560	
$V_{CE(sat)}$	$I_C=-50\text{mA}$ $I_B=-5.0\text{mA}$		-0.06	-0.5	V
f_T	$V_{CE}=-6.0\text{V}$ $I_C=-10\text{mA}$		100		MHz
r_{bb}	$V_{CE}=-6.0\text{V}$ $I_C=-1.0\text{mA}$ $f=30\text{MHz}$		2.0	4.0	Ω
NV	$V_{CE}=-10\text{V}$ $I_C=-1.0\text{mA}$ $R_g=100\text{k}\Omega$			150	mV

h_{FE} 分档/ h_{FE} classifications: Q:120~270 R:180~390 S:270~560